



SF51 - SF58

5 амперный супербыстродействующий диод

диапазон напряжения
от 50 до 600 вольт
ток 5 ампер

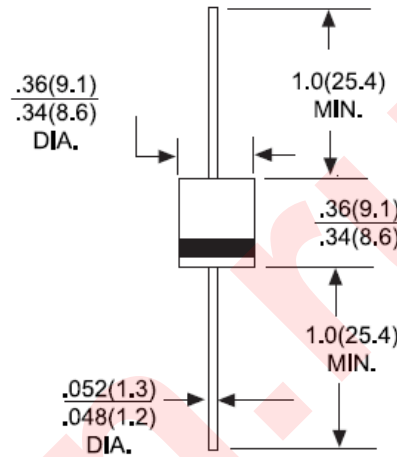
ОСОБЕННОСТИ:

- Низкое прямое падение напряжения
- Номинальное напряжение до 1000В
- Высокая допустимая нагрузка по току
- Высокая надежность
- Высокая перегрузочная способность

Механические данные

- Корпус: литой пластиковый корпус R-6
- Пластиковые материалы UL классификация воспламеняемости 94 V-0
- Вывода: аксиальные выводы, пайка в MIL-STD-202, методика 208
- Полярность: цветное кольцо обозначает катод
- Высокая температура пайки, гарантированно: 250°C в течение 10 секунд
- Монтажное положение: любое
- Вес: 1,20 грамма

R-6



Размеры в дюймах и (мм)

МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.

Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.

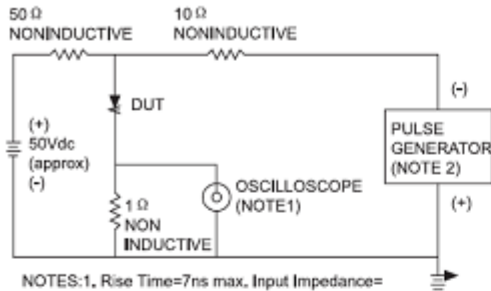
Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%

ТИП		SF51	SF52	SF53	SF54	SF55	SF56	SF57	SF58	Единица измерения	
Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение	VRRM	50	100	150	200	300	400	500	600	В	
Максимальное среднеквадратическое значение напряжения	VRMS	35	70	105	140	210	280	350	420	В	
Максимальное постоянное запирающее напряжение	VDC	50	100	150	200	300	400	500	600	В	
Максимальный средний прямой выпрямленный ток T = 55°C	IF(AV)	5.0								А	
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. (JEDEC метод)	IFSM	140								А	
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 3А	VF	0.95			1.3		1.7			В	
Максимальный постоянный обратный ток при номинальном постоянном обратном напряжении Tj = 25°C Tj = 100°C	IR	5 100								мкА	
Типичное время обратного восстановления (Примечание 2)	TRR	35								нсек.	
Типичная емкость перехода, на выводах (Примечание 1)	CJ	110				55					пФ
Диапазон рабочих температур	TJ	-55 до +125								°C	
Диапазон температур хранения	TSTG	-55 до +150								°C	

Примечание: 1. Измеряется на частоте 1.0 МГц и обратном постоянном напряжении 4,0 В.

2. Обратное восстановление, условия тестирования: IF = 0.5А, IR = 1,0А, IRR= 0.25А.

FIG.1- REVERSE RECOVER TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM



NOTES: 1. Rise Time=7ns max, Input Impedance=1 megohm 22pf
2. Rise Time=10ns max, Source Impedance=50 ohms

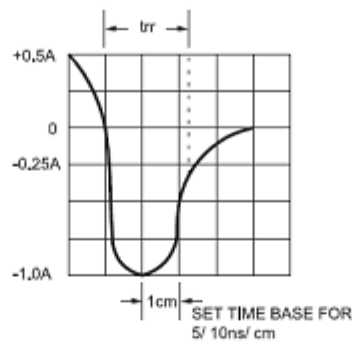


FIG.2- MAXIMUM AVERAGE FORWARD CURRENT DERATING

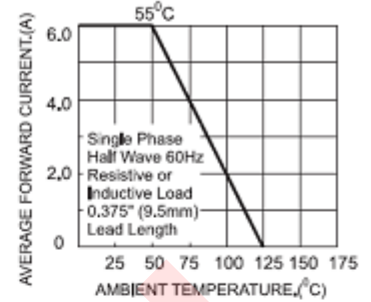


FIG.3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

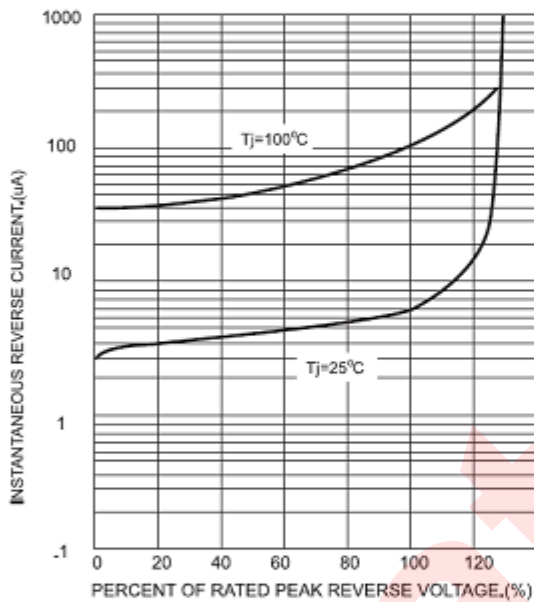


FIG.4- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

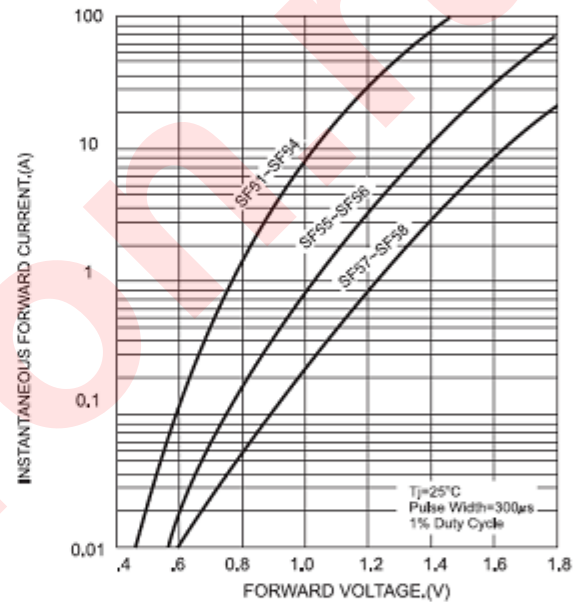


FIG.5- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

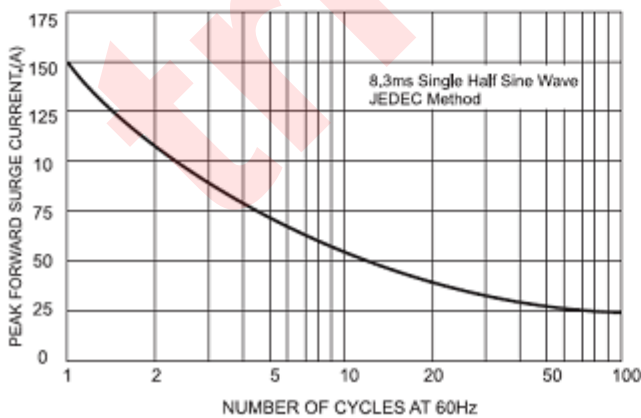


FIG.6- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

